PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-305917

(43) Date of publication of application: 28.10.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/027

(21)Application number : 03-094863

(71)Applicant : NIKON CORP

(22)Date of filing:

02.04.1991

(72)Inventor: OZEKI HISAO

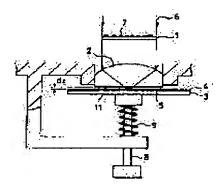
MATSUBARA TAKASHI

(54) ADHESION TYPE EXPOSURE DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To thin film thickness of an immersion liquid and reduce the quantity of light absorbed, and to minimize and prevent exposure unevenness in an adhesion type exposure device.

CONSTITUTION: The adhesive surface 11 of an exposure lens is hydrophilic—treated by a hydrophilic solution such as alcohol. A wafer 3 coated with a photoresist 4 is fast stuck on the hydrophilic—treated adhesive surface 11 through an immersion liquid 5, and the pattern 7 of a photomask 1 is transferred onto the wafer 3 by the irradiation of irradiation light 6. Wafer absorbing properties are improved in the hydrophilic—treated adhesive surface 11, and the film thickness of the immersion liquid 5 is made thin.



LEGAL STATUS

Date of request for examination

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 04305917 A

(43) Date of publication of application: 28.10.92

(51) Int. CI H01L 21/027

(21) Application number: 03094863 (71) Applicant: NIKON CORP

(22) Date of filing: 02.04.91 (72) Inventor: OZEKI HISAO MATSUBARA TAKASHI

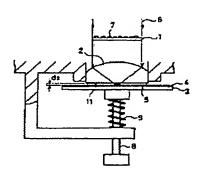
(54) ADHESION TYPE EXPOSURE DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To thin film thickness of an immersion liquid and reduce the quantity of light absorbed, and to minimize and prevent exposure unevenness in an adhesion type exposure device.

CONSTITUTION: The adhesive surface 11 of an exposure lens is hydrophilic- treated by a hydrophilic solution such as alcohol. A wafer 3 coated with a photoresist 4 is fast stuck on the hydrophilic-treated adhesive surface 11 through an immersion liquid 5, and the pattern 7 of a photomask 1 is transferred onto the wafer 3 by the irradiation of irradiation light 6. Wafer absorbing properties are improved in the hydrophilic-treated adhesive surface 11, and the film thickness of the immersion liquid 5 is made thin.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio



BEST AVAILABLE COPY

(19) [本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-305917

(43)公開日 平成4年(1992)10月28日

(51) Int.Cl. ⁵ H 0 1 L 21/027	識別記号	庁内整理番号	FI		技術表示箇所
		7013-4M 7352-4M	H01L 21/30	341 S 311 A	

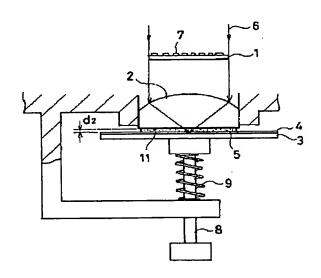
		審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)			
(21)出願番号	特願平3-94863	(71)出願人 000004112 株式会社ニコン			
(22)出願日	平成3年(1991)4月2日	東京都千代III区丸の内3丁目2番3号 (72)発明者 大関 尚夫 東京都品川区西大井一丁目6番3号 株式 会社ニコン大井製作所内			
		(72)発明者 松原 隆 東京都品川区西大井一丁目6番3号 株式 会社ニコン大井製作所内			
		(74)代理人 弁理士 山川 政樹			

(54)【発明の名称】 密着型露光装置

(57)【要約】

[目的] 密着型解光装置において、浸液の膜厚を薄くして光の吸収量を少なくし、露光ムラを軽減防止することを目的とする。

【構成】 國光レンズの密着而11をアルコール等の親水溶液によって親水化処理する。この親水化処理された密着面11にフォトレジスト4を塗布されたウエハ3を浸液5を介して密着させ、照射光6の照射によりフォトマスク1のパターン7をウエハ3上に転写する。親水化処理された密着面11は、吸水性が向上し、浸液5の膜厚を薄くする。



特開平4-305917

(2)

【特許請求の範囲】

【
聞求項1】
投影光学系もしくはフォトマスクのウエ ハ密着面を親水化処理し、この親水化処理された密着面 にフォトレジストを塗布されたウエハを浸液を介して密 澄させ、照射光の照射によりフォトマスクのパターンを 前記フォトレジストに転写するようにしたことを特徴と する密着型露光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、LSIの製造工程にお 10 うにした密着型露光装置を提供することにある。 いて、フォトマスク上のパターンをウエハ上に投影路光 する露光装置、特に密菪型露光装置に関するものであ

[0002]

【従来の技術】レーザー光等を照射しフォトマスク上の パターンを投影光学系によってシリコンウエハ等の半導 体基板上に投影露光するこの種の露光装置における露光 方式としては、①密着(コンタクト)露光方式、②プロ キシミティ露光方式、③反射型投影露光方式、④縮小レ ンズ投影露光方式の4方式が知られている。

【0003】このうち密着露光方式は、フォトマスク (または投影光学系) とウエハとを密着させて腐光する もので、これらが完全に密着している場合には、フォト レジスト中の波長が屈折率分の1に短くなるため、回折 の影響が少なく、高解像度の転写が得られるという特色 を有している。しかし、完全な密着を実現することは極 めて難しく、またフォトマスクとウエハとを機械的に接 触させているためにウエハ表面の突起等によりフォトマ スクに欠陥が生じ、その寿命を低下させると同時にデバ イスの歩留りに影響を及ぼすといった問題があった。

[0004] そこで、密着露光方式によるこのような問 題を解決する方法としてフォトマスクとウエハ間に液体 (浸液)を充填している。図2は投影光学系にウエハを 密着させた場合を示すもので、1はフォトマスク、2は 投影光学系の一部を構成する露光レンズ、3はフォトレ ジスト4が塗布されたウエハ、5は露光レンズ2とウエ ハ3間に充填された浸液、6はフォトマスク1のパター ン7を照射しフォトレジスト4を露光する照射光、8は ウエハ3を保持する保持体、9は保持体8を上方に付勢 しウエハ3を露光レンズ2に押し付ける圧縮コイルばね 40 である。照射光6の波長は短いほど回折の影響が少な く、そのため光源としてエキシマレーザー等のレーザー 装置が用いられる。浸液5としては、屈折率がフォトレ ジスト4と同程度で光の吸収が少なく、しかもフォトレ ジスト4を溶かさないものが望ましく、通常純水が使用 される。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し たような浸液6を使用した密着型露光装置においては、 ∂ 被 δ 自身の膜厚ムラがあると、 ∂ 液 δ による服射光 δ ののののののでは、 δ ののでは、 δ のでは、 δ のでは、 δ のです。

の吸収量にムラが生じるため、コンタクト露光されたフ ォトレジスト4のパターンが的確に観光されている部分 とそうでない部分とが生じてしまうという問題があっ た。したがって、このような露光ムラの発生を防止する ため、浸液5の膜厚d1を薄くし、光の吸収ムラを少な くすることが望まれている。

【0006】本発明は上述したような従来の問題点およ び要望に鑑みてなされたもので、その目的とするところ は、浸液の膜厚を薄くし、露光ムラを軽減防止し得るよ

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成 するため、投影光学系もしくはフォトマスクのウエハ密 着面を親水化処理し、この親水化処理された密着面にフ ォトレジストを塗布されたウエハを浸液を介して密着さ せ、照射光の照射によりフォトマスクのパターンを前記 フォトレジストに転写するようにしたものである。

[0008]

【作用】本発明において、親水化処理された投影光学系 もしくはフォトマスクのウエハ密着面は、吸水性が向上 し、浸液の膜厚を薄くする。

[0009]

【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて 詳細に説明する。図1は本発明に係る密着型露光装置の ―実施例を示す要部の断面図である。なお、図中図2と 同一構成部品のものに対しては同一符号を以て示し、そ の説明を省略する。本実施例は投影光学系にウエハを密 着させた場合を示すもので、フォトマスク投影光学系の 一部を構成する露光レンズ2のウエハ密着面11を予め 親水化処理し、この親水化処理された密着面11にウエ ハ3を純水等の浸液5を介して密着させ、照射光6の照 射によりフォトマスク1のパターン7をウエハ3上に転 写するようにしたものである。

[0010] 親水化処理は、アルコール系等の親水溶液 で密着面11を奇麗に拭き、レンズ表面の汚れを取るこ とで行なわれる。そして、この親水化処理後密着面 1 1 にウエハ3を浸液5を介して密着させ、ウエハ3を露光 レンズ2にばね9により所定圧にて押しつける。

【0011】かくしてこのような構成においては、親水 化処理によって密着面11の吸水性を向上させているの で、親水化処理を施さなかったときと比較して浸液5の 吸水効果が大きく、したがって、浸液5の表面張力が小 さくなって濡れ性が上がるため、浸液5の膜厚d2 を図 2に示した従来装置と比較して薄くする (d2 <d1) ことができ、また膜厚が薄くなれば光の吸収量も少なく なるので、これに比例して光の吸収ムラが減少し、露光 ムラを軽減防止することができる。

[0012]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る密着型

BEST AVAILABLE COPY

(3)

特開平4-305917

.3

エハ密着面を親水化処理し、この親水化処理された密着面に、フォトレジストを塗布されたウエハを浸液を介して密着させるように構成したので、浸液自身の表面張力を減らして溜れ性を向上させることができる。したがって、浸液の膜厚を薄くするができ、また膜厚が薄くなれば浸液の膜厚ムラも少なくなるため、光の吸収が少なく、浸液による露光ムラを軽減防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る密着型露光装置の一実施例を示す 要部の断面図である。

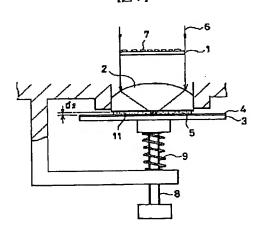
【図2】密着型露光装置の従来例を示す要部の断面図で

ある。

【符号の説明】

- 1 フォトマスク
- 2 欧光レンズ
- 3 ウエハ
- 4 フォトレジスト
- 5 浸液
- 6 照射光
- 7 マスク
- 10 11 密着面

【図1】



[図2]

